

昆明理工大学 2008 年硕士研究生招生入学考试试题(A 卷)

考试科目代码： 809

考试科目名称： 材料科学基础

试题适用招生专业： 材料物理化学 材料学 材料成型与控制 生物工程材料

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。
- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。
- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。
- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一 选择题（每题 2 分，共 40 分）

- 1 晶体结构和空间点阵之间的关系为：_____。
- A 空间点阵反映晶体结构中质点排列的周期规律性
B 空间点阵等同于晶体结构
C 空间点阵的结点就是晶体结构中的原子
D 空间点阵和晶体结构没有关系
- 2 已知 NaCl 晶体结构属于立方晶系，则其晶体结构常数关系为_____。
- A $a \neq b \neq c, \alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$ B $a \neq b = c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
C $a = b = c, \alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$ D $a = b = c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
- 3 菱方晶系中，只具有_____。
- A 简单点阵 B 底心点阵 C 体心点阵 D 面心点阵
- 4 密排六方结构中，几何特征描述正确的是_____。
- A 配位数：8 一个晶包内的原子数：2 紧密系数：0.68
B 配位数：12 一个晶包内的原子数：6 紧密系数：0.74
C 配位数：12 一个晶包内的原子数：4 紧密系数：0.74
D 配位数：12 一个晶包内的原子数：6 紧密系数：0.68
- 5 凡是外层电子填充在 4f 轨道上的元素称为_____。
- A 过渡族元素 B 副族元素 C 镧系元素 D 主族元素
- 6 在正离子周围形成一负离子配位多面体，正负离子之间的距离取决于离子半径之和，而配位数取决于_____。
- A 正离子半径的大小 B 正负离子半径的比值
C 负离子半径的大小 D 正负离子的电负性

昆明理工大学 2008 年硕士研究生招生入学考试试题

7 按照晶体结构，可将合金相分为_____。

- A 置换固溶体和间隙固溶体 B 离子晶体和原子晶体
C 固溶体和化合物 D 共价键化合物和原子键化合物

8 正负离子间通过电子的转移(离子键)和/或电子共用(共价键)而形成的 8 电子组态 ns^2np^6 的化合物为 _____。

- A 原子价化合物 B 离子键化合物 C 共价键化合物 D 正常价化合物

9 硅酸盐晶体结构中，每一个氧最多只可能被_____ $[SiO_4]$ 四面体共有。

- A 1 B 2 C 3 D 4

10 体心立方金属的滑移方向总是原子排列的密排方向，即_____。

- A $<111>$ B $<110>$ C $<101>$ D $<011>$

11 金属 Ag 的晶体结构为面心立方点阵，其滑移面和滑移方向分别为_____。

- A $\{111\}$, $<111>$ B $\{111\}$, $<110>$
C $\{001\}$, $<111>$ D $\{001\}$, $<110>$

12 刃型位错滑移时，其运动方向与柏氏矢量_____, 与外加切应力 τ _____, 与位错线_____.

- A 垂直, 垂直, 垂直 B 平行, 平行, 垂直
C 垂直, 平行, 垂直 D 平行, 垂直, 平行

13 从微观上看，单晶体范性形变的基本方式只有两种，即_____ 和_____。

- A 滑移, 孪生 B 弹性形变, 朔性形变
C 滑移, 弹性形变 D 孪生, 迁移

14 在 Cu-Ni 合金匀晶相图中，自由度最大和最小分别为_____ 和_____。

- A 1, 0 B 2, 1 C 3, 1 D 2, 0

15 典型的共晶组织多为层片状和棒状，形成何种形状取决于_____。

- A 组元晶体结构
B 组元溶解度大小
C 固溶体晶体结构
D 两相的体积分数和比表面能

16 界面上原子同时处于两相晶格结点上，或者两相晶格的原子在界面处相互吻合这种界面称为_____。

- A 共格界面 B 半共格界面 C 非共格界面 D 复杂半共格界面

昆明理工大学 2008 年硕士研究生招生入学考试试题

- 17 在金属的热处理回复过程中与空位变化有关的阶段为 _____。
A 低温回复 B 中温回复 C 高温回复 D 整个回复阶段
- 18 结晶过程一般分为 _____ 和 _____。
A 结晶方式和晶核形成 B 晶核形成和晶核长大
C 具有过冷度和晶核形成 C 越过势垒和长大方式
- 19 铸锭三晶区为 _____、_____ 和 _____。
A 包晶区、共晶区和匀晶区
B 细晶区、柱状晶区和中心等柱晶区
C 粗晶区、胞状晶区和树枝状晶区
D 单晶区、共生晶区和复杂晶区
- 20 按动力学机制，相变分为 _____、_____。
A 自动转变和非自动转变 B 可逆转变和不可逆转变
C 匀相转变和非匀相转变 D 固相相变和液相相变

二 名词解释（每题 4 分，共 20 分）

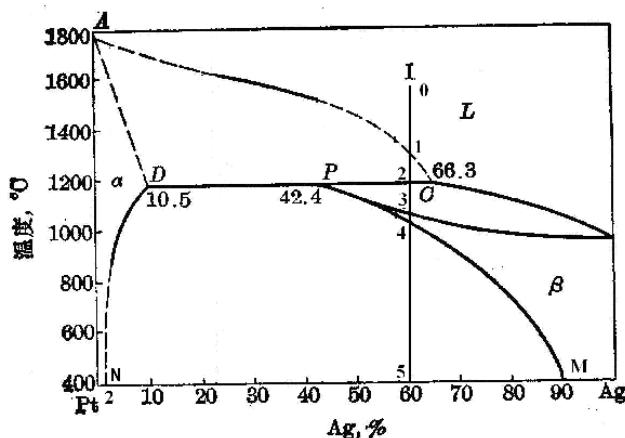
- 1 晶体
- 2 禁带
- 3 弹性形变
- 4 位错线
- 5 Kirkendall 效应

三 简答题（每题 5 分，共 30 分）

- 1 从能带的角度解释半导体为什么能够导电。
- 2 简述多电子原子核外电子排布所遵循的原则。
- 3 在立方晶胞中绘出(011), (111), (121)晶面及[110], [121]晶向。
- 4 试述浓度三角形中等含量规则、等比例规则和背向规则。
- 5 什么是柯氏气团，解释其引起体心立方金属的明显屈服现象。
- 6 何谓序参量？一级相变和二级相变中序参量的变化有何不同？

四 综合题 (共 60 分)

- 1 为何金属材料经热加工后机械性能较铸件状态为佳? (8分)
- 2 分析纯金属生长形态与温度梯度的关系? (8分)
- 3 根据 Pt-Ag 相图, (1) 说明成分为 I 合金的平衡凝固过程及室温组织; (2) 计算包晶反应刚好结束时相组成物的相对量。 (10分)



- 4 设有一条内径为 30mm 的厚壁管道, 被厚度为 0.1mm 的铁膜隔开, 通过管子的一端向管内输入氮气, 保持膜片一侧氮气浓度为 1200 mol/m^3 , 而另一侧的氮气浓度为 100 mol/m^3 , 则此时为稳态扩散。如在 700°C 下测得通过管道的氮气扩散通量为 $4.4 \times 10^{-4} \text{ mol/(m}^2 \cdot \text{s})$, 求此时的扩散系数。
- 5 面心立方晶体中有 $b = \frac{a}{2}[\bar{1}01]$ 的单位位错及 $b = \frac{a}{6}[12\bar{1}]$ 的不全位错, 此二位错相遇产生位错反应。(12分)

- (1) 写出反应式, 判断反应能否进行?
- (2) 写出合成位错的柏氏矢量并说明合成位错的类型。

- 6 在固态有限互溶的三元共晶相图综合投影图中, 写出所有二元共晶反应, 并标明共晶终了面, 说明 O 合金的凝固过程。(12分)

